








	<h2>SI3458DV-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3458DV-T1-E3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 3.2A 6-TSOP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3458DV-T1-E3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 26637 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3458DV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 3.2A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	26637 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 3.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)







SI3458DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3458DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3458DV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3458DV-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3459-KIT</b> Energy Micro (Silicon Labs) EVAL KIT FOR SI3459 POE CTRL</p>	 <p><b>SI3458DV-T1-E3CT-ND</b> Vishay Precision Group SI3458DV-T1-E3CT-ND VISHAY</p>	 <p><b>SI3458DV</b> Vishay Precision Group SI3458DV VISHAY</p>	 <p><b>SI3458BDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 4.1A 6- TSOP</p>
 <p><b>SI3458BDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 4.1A 6- TSOP</p>	 <p><b>SI3458DV-T1-GE3</b> VISHAY SI3458DV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SI3459-B02-IMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC POE PSE 8 PORT 802.3AT 56QFN</p>	 <p><b>SI3459-B02-IM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC POE PSE 8 PORT 802.3AT 56QFN</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI3456DV-T1	 SI3456DV-T1-E3	 SI3456DV-T1-GE3	 SI3457-B02-IT	 SI3457BDV
 SI3457BDV-T1	 SI3457BDV-T1-E3	 SI3457BDV-T1-E3	 SI3457BDV-T1-GE3	 SI3457BDV-T1-GE3
 SI3457CDV-T1-E3	 SI3457CDV-T1-E3	 SI3457CDV-T1-GE3	 SI3457CDV-T1-GE3	 SI3457DV
 SI3457DV	 SI3457DV-T1	 SI3457DV-T1-E3	 SI3457DV-T1-GE3	 SI3457DV-TI-E3
 SI3458BDV-T1-E3	 SI3458BDV-T1-E3	 SI3458BDV-T1-GE3	 SI3458BDV-T1-GE3	 SI3458DV-T1-E3
 SI3458DV-T1-GE3	 SI3459BDV-T1-E	 SI3459BDV-T1-E3	 SI3459BDV-T1-E3	 SI3459BDV-T1-GE3
 SI3459BDV-T1-GE3	 SI3459DV-T1-E3	 SI3459DV-T1-E3	 SI3459DV-T1-GE3	 SI3460-E02-GMR
 SI3460-E03-GMR	 SI3460BDV-T1-E3	 SI3460BDV-T1-E3	 SI3460BDV-T1-GE3	 SI3460BDV-T1-GE3
 SI3460DDV	 SI3460DDV-T1-GE3	 SI3460DDV-T1-GE3	 SI3460DV	 SI3460DV-T1
 SI3460DV-T1-E3	 SI3460DV-T1-E3	 SI3460DV-T1-GE3	 SI3460DV-T1-GE3	 SI3461DV-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited